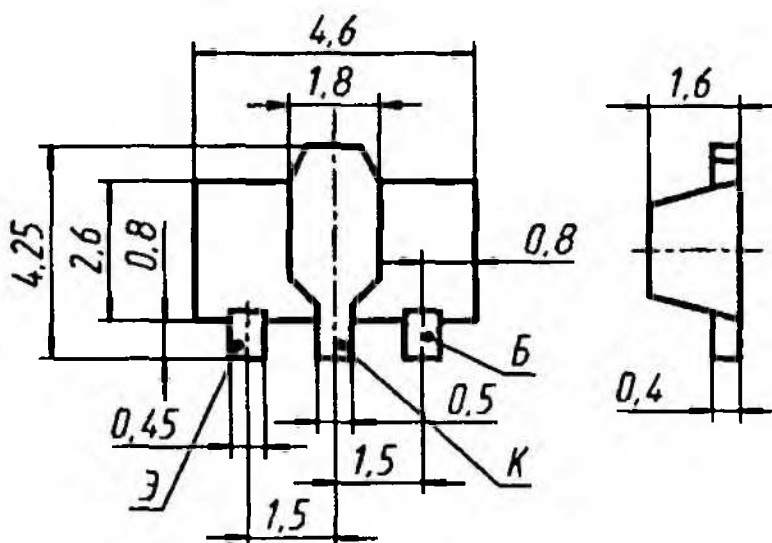


2Т665А9, 2Т665Б9, КТ665А9, КТ665Б9

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* универсальные. Предназначены для применения в усилителях и переключающих устройствах. Выпускаются в пластмассовом корпусе с жесткими выводами. Маркируются условными знаками: 2Т665А9 — 2А, 2Т665Б9 — 2Б, КТ665А9 — КА, КТ665Б9 — КБ. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,1 г.

2Т665(А9,Б9), КТ665(А9,Б9)



Электрические параметры

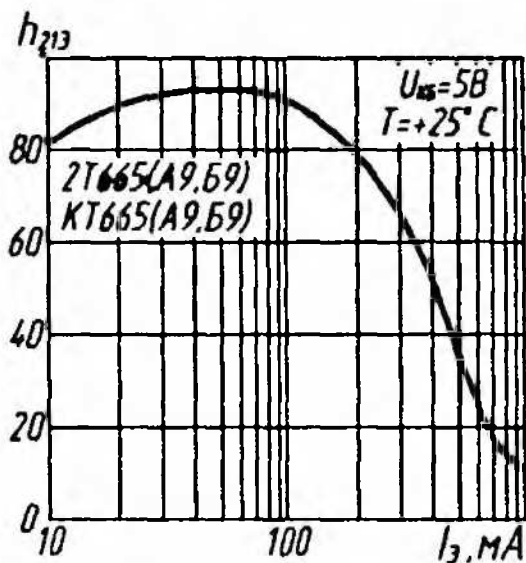
Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 2 \text{ В}$, $I_3 = 0,15 \text{ А}$	40...250
Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме ОЭ при $U_{КБ} = 5 \text{ В}$, $I_3 = 50 \text{ мА}$, типовое значение	200* МГц
Граничное напряжение при $I_3 = 30 \text{ мА}$, не менее:	
2Т665А9, КТ665А9	80 В
2Т665Б9, КТ665Б9	60 В
Напряжение насыщения коллектор—эмиттер при $I_к = 0,15 \text{ А}$, $I_б = 15 \text{ мА}$, не более	0,3 В
Напряжение насыщения база—эмиттер при $I_к = 0,15 \text{ А}$, $I_б = 15 \text{ мА}$, не более	1,1 В
Время включения при $U_{КЭ} = 20 \text{ В}$, $I_к = 0,2 \text{ А}$, $I_б = 40 \text{ мА}$, не более	0,1 мкс
Время выключения при $U_{КЭ} = 20 \text{ В}$, $I_к = 0,2 \text{ А}$,	

$I_B = 40$ мА, не более	0,5 мкс
Время спада при $U_{КЭ} = 20$ В, $I_K = 0,2$ А, $I_B = 40$ мА, не более	0,2 мкс
Емкость коллекторного перехода при $U_{КБ} = 5$ В, не более	25 пФ
Емкость эмиттерного перехода при $U_{ЭБ} = 0,5$ В, не более	150 пФ
Обратный ток коллектора при $U_{КБ} = 100$ В, не более	10 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{ЭБ} = 5$ В, не более	10 мкА

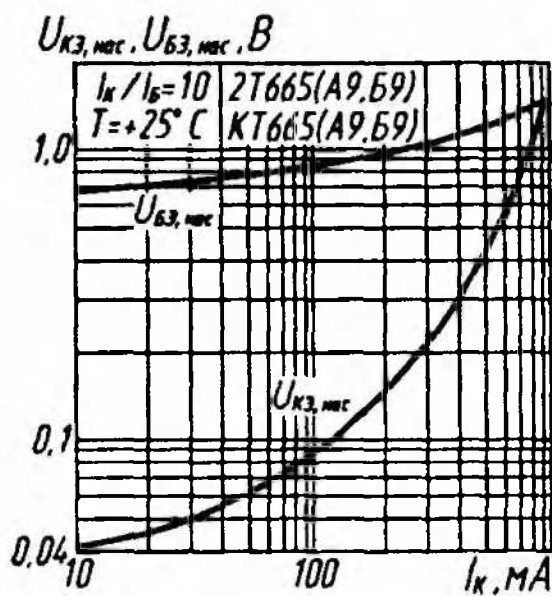
Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база:	
2Т665А9, КТ665А9	120 В
2Т665Б9, КТ665Б9	100 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер:	
при $R_{БЭ} = 1$ кОм:	
2Т665А9, КТ665А9	100 В
2Т665Б9, КТ665Б9	80 В
при $R_{БЭ} = \infty$:	
2Т665А9, КТ665А9	80 В
2Т665Б9, КТ665Б9	60 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	5 В
Постоянный ток коллектора	1 А
Импульсный ток коллектора при $t_H = 10$ мс	1,5 А
Постоянный ток базы	0,3 А
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T_K = -60...+25$ °С:	
с теплоотводом	1 Вт
без теплоотвода	0,3 Вт
Температура $p-n$ перехода	+150 °С
Температура окружающей среды	-60... $T_K =$ = +100 °С

Транзисторы являются комплементарными с транзисторами 2Т664А9, 2Т664Б9, КТ664А9, КТ664Б9.



Зависимость статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимости напряжений насыщения коллектор—эмиттер и база—эмиттер от тока коллектора